

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

(18) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2001-152134

(P2001-152134A)

(43) 公開日 平成13年6月5日 (2001.6.5)

(51) IntCl ⁷	識別記号	FI	キーワード (参考)
C09K 3/14	550	C09K 3/14	550D
			550Z
H01L 21/304	622	H01L 21/304	622D

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全5頁)

(21) 出願番号 特願平11-331377

(22) 出願日 平成11年11月22日 (1999.11.22)

(71) 出願人 000107745

スピードファム株式会社

神奈川県綾瀬市早川2647

(72) 発明者 田中 弘明

神奈川県綾瀬市早川2647 スピードファ

ム・アイベック株式会社内

(72) 発明者 吉田 明利

神奈川県綾瀬市早川2647 スピードファ

ム・アイベック株式会社内

(74) 代理人 100089408

弁理士 田中 宏 (外1名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 酸化物単結晶ウェーハ用研磨用組成物及び酸化物単結晶ウェーハの研磨方法

(57) 【要約】

【目的】 タンタル酸リチウムあるいはニオブ酸リチウム等、比較的高硬度の酸化物単結晶ウェーハの効率的ポリッシング加工を行なう研磨用組成物を提供する。

【構成】 BET法により測定した比表面積より真球換算で算出した平均一次粒子径Aが40~150nmであり、かつマイクロトラックUPAによるレーザー散乱法で測定した平均二次粒子径Bとの径の比率B/Aが1以上1.4未満の酸化珪素粒子を含み、酸化珪素粒子の溶液全体での含有率が3~25重量%のコロイド溶液であり、更に25℃における導電率が酸化珪素1重量%あたり10mS/m以上であるように導電性を与える成分を含有し、かつpHが8~11の間にあることを特徴とする酸化物単結晶ウェーハ用の研磨用組成物および研磨方法である。

【特許請求の範囲】

【請求項1】BET法により測定した比表面積より真球換算で算出した平均一次粒子径Aが40～150nmであり、かつマイクロトラックUPAによるレーザー散乱法で測定した平均二次粒子径Bとの径の比率B/Aが1以上1.4未満の酸化珪素粒子を含み、酸化珪素粒子の溶液全体での含有率が3～25重量%のコロイド溶液であり、更に25℃における導電率が酸化珪素1重量%あたり10mS/cm以上であるように導電性を与える成分を含有し、かつ、pHが8～11の間にあることを特徴とする酸化物単結晶ウェーハ用研磨用組成物。

【請求項2】導電性を与える成分が、アルカリ金属、コリン、テトラメチルアンモニウムまたはアンモニウムの塩のうち少なくとも一つであることを特徴とする請求項第1項記載の酸化物単結晶ウェーハ用研磨用組成物。

【請求項3】請求項第1項ないし第2項記載の酸化物単結晶ウェーハ用の研磨用組成物において、酸化物単結晶ウェーハが、タンタル酸リチウムあるいはニオブ酸リチウムの単結晶ウェーハであることを特徴とする酸化物単結晶ウェーハ用研磨用組成物。

【請求項4】上下両面あるいは片面に、合成樹脂発泡体、合成皮革あるいは不織布等からなるポリッシングパッドを貼付した回転可能な定盤を有する研磨機に、酸化物単結晶ウェーハを載置押圧し、請求項第1項ないし請求項第3項に記載の研磨用組成物を供給しつつ、前記定盤および酸化物単結晶ウェーハの双方あるいはそのいずれか一方を回転することにより、前記酸化物単結晶ウェーハ用の研磨を行なう方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明が属する技術分野】本発明は、弾性表面波素子や電気光学素子等の基板となる強誘電体ウェーハとして広く用いられるタンタル酸リチウムあるいはニオブ酸リチウム等の酸化物単結晶ウェーハの表面を鏡面研磨する方法に関する。特に本発明は、高い導電率を持つコロイダルシリカの水分散物を主成分とする研磨用組成物を用いたタンタル酸リチウムまたはニオブ酸リチウムよりなる硬質の酸化物単結晶ウェーハの表面を高速度でしかも優れた面粗さで鏡面研磨を行なう方法に関する。

【0002】

【従来技術】近年の携帯電話、コードレスホンあるいは自動車電話等の移動体通信の急激な発達により、タンタル酸リチウムあるいはニオブ酸リチウムよりなる酸化物単結晶ウェーハの生産が増加している。これらのタンタル酸リチウム、ニオブ酸リチウムなどの酸化物単結晶は硬度（モース硬度で5～8）が高いため、通常のポリッシング方法では研磨速度が遅く、所定の厚みを得るために、10時間近い研磨時間を要する場合もあり、その生産性と効率の低さが指摘されていた。

【0003】一般的な研磨方法としては、例えば超精密

生産技術体系第2巻（フジテクノシステム発行）の1025ページにおいて、「・・・コロイダルシリカをベースとしたアルカリ系スラリーにより、安定した表面状態が得られる。市販品には、平均粒子径が20～120nm程度で、有機アミン、NaOHなどでpH9.0～10.5レベルに調整した研磨剤が普及している。」との記載があり、これは通常のシリコンウェーハ等のポリッシングに用いられる方法を、ほぼそのまま踏襲したものであり、現状においては、上述の通り、この方法による研磨速度の低さが指摘されているものである。

【0004】従来より様々な研磨用組成物がタンタル酸リチウム、ニオブ酸リチウムよりなる酸化物単結晶の鏡面研磨を行なうための研磨用組成物として提案されている。例えば、特開平6-191988では、コロイダルシリカ、コロイダルアルミナあるいはコロイダルジルコニアよりなる研磨剤に、加工液としてKOH、NaOH、NaClO、ブリーチメタノールを加えて用いることが提案されている。しかしながら、タンタル酸リチウム、ニオブ酸リチウムよりなる酸化物単結晶は、前述の通り硬度が高いことその他に、化学的にも非常に安定な化合物であるため、例えばアルカリあるいは酸化剤等の薬剤によってもほとんど侵蝕されることがなく、そのため、メカノケミカル的な研磨方法を用いても、研磨速度が改善されることはほとんどない。

【0005】また、特開平3-54287では、仮焼アルミナ粉末を含有した研磨用組成物が提案されている。更に、特開平5-1279では、BET比表面積が10～60m²/gで、二次粒子径が0.5～5μmである沈降法シリカの水性スラリー分散液を研磨用組成物として使用する方法が提案されている。しかしながら、これらの方法は、比較的粒子径の大きな研磨剤砥粒を用いており、高精度の鏡面は得られずまたスクラッチの発生も多く、最終的な鏡面仕上げにおける研磨速度の改善を目的としたものではない。

【0006】研磨速度を改善する一つの方法としては、研磨剤としての砥粒の濃度を高濃度にする方法もある。しかしながら、この方法もある濃度を超えると、研磨速度が飽和値に達して、所期の効果は得られずむしろスクラッチの発生や、研磨液循環作業への弊害が目立つようになり、完全なものではない。更に、研磨速度改善の方法として、ダイヤモンド、窒化硼素等の超硬砥粒を使用する方法も考えられるが、最終的な鏡面を得るに迫った超微粉は得にくい。

【0007】

【発明が解決しようとする課題】本発明者等は、前述の従来の技術の持つ問題点に鑑み、二酸化珪素（SiO₂；以下酸化珪素と記す）のコロイド状の粒子（コロイダルシリカと記す）を研磨用砥粒として用いることを基本とする方法での研磨速度の向上を行なう方法について鋭意研究を行なった結果、ある一定範囲のサイズの粒

子径を持ち、その二次凝集を狭い範囲に抑えたコロイダルシリカを、ある一定の導電率とpHの条件におくこと
によって、タンタル酸リチウムまたはニオブ酸リチウム
よりなる酸化物単結晶ウェーハの鏡面仕上げに適した研
磨用組成物が得られることを見出して本発明を完成する
に至ったものである。すなわち、本発明の目的は、酸化
物単結晶ウェーハの表面を、極めて優れた面粗さでしか
も高速で鏡面研磨を行なうに適した研磨用組成物を提供
することにある。更に、本発明の他の目的は前記研磨用
組成物を用いて、酸化物単結晶ウェーハの表面を鏡面研
磨する方法を提供することにある。

【0008】上述の目的は、BET法により測定した比
表面積より真球換算で算出した平均一次粒子径Aが40
～150nmであり、かつマイクロトラックUPAによる
レーザー散乱法で測定した平均二次粒子径Bとの径の
比率B/Aが1以上1.4未満の酸化珪素粒子を含み、
該酸化珪素粒子の溶液全体に対する含有率が3～25重
量%のコロイド状溶液であり、更に25℃における導電
率が酸化珪素1重量%あたり10mS/m以上であるよう
に導電性を与える成分を含有し、かつpHが8～11
の間にあることを特徴とする酸化物単結晶ウェーハ用研
磨用組成物にて達成される。更に、本発明の他の目的
は、上下両面あるいは片面に、合成樹脂発泡体、合成皮
革あるいは不織布等からなるポリッシングパッドを貼付
した回転可能な定盤を有する研磨機に、酸化物単結晶ウ
ェーハを載置押圧し、請求項第1項ないし請求項第3項
に記載の研磨用組成物を供給しつつ、前記定盤および酸
化物単結晶ウェーハの双方あるいはそのいずれか一方を
回転することにより、前記酸化物単結晶ウェーハ用の研
磨を行なう方法にて達成される。

【0009】

【発明の実施の形態】本発明の肝要は、研磨に用いる研
磨用組成物の中に含まれる酸化珪素粒子の平均一次粒子
径が40～150nmであり、その粒子の二次凝集は、
一次粒子の径Aと二次粒子の径Bとの比率B/Aが1.
4未満に抑えられている点にあり、更に、導電性成分の
添加により導電性を与えられた液である点にある。研磨
用組成物中の凝集にかかる形態、すなわち、ほとんど二
次凝集がなく単分散に近いようにすることにより、スク
ラッチ等の欠点の発生に繋がる大型粒子がなく、極めて
優れた仕上げ面粗さを持った面が得られ、かつ、導電性
成分の添加により研磨速度を顕著に向上させることがで
きるのである。

【0010】本発明においては平均一次粒子径の測定
は、BET法により測定した比表面積より真球換算で算
出した値を用い、また、平均二次粒子径としてはマイク
ロトラックUPA (Honeywell社製) によるレ
ーザー散乱法で測定した体積平均粒子径を用いる。コロ
イダルシリカの平均一次粒子径が40nm以下である
と、研磨速度は十分に向上しない。また、平均一次粒子

径が150nm以上を超えると、スクラッチ等の欠点が
発生し易くなり、また仕上げ面粗さも良くなく好ましく
ない。一般に微細粒子が凝集する場合は、フロック化
し、巨大粒子化する傾向が強いが、本発明においては平
均一次粒子径Aと平均二次粒子径Bとの比率、B/Aが
1.4未満に抑えられている点にあるものを用いること
をその重要な点とする。粒子径の比率B/Aが1.4以
上であると、スクラッチが生じ易く、極めて優れた面粗
さを持った仕上がり面の創成といった点で効果が不十分
である。

【0011】本発明に用いるコロイド状の酸化珪素は、
水ガラスから脱アルカリを行なって製造されるコロイダ
ルシリカ、有機ケイ素化合物を加水分解して得られたコ
ロイダルシリカ、フェームドシリカを水に分散させたコ
ロイダルシリカ等いずれも使用でき、特に製法には限定
されなく、極めて微細な酸化珪素微粉がコロイド状に分
散されたものである。そして、研磨時のシリカ濃度は3
～25重量%の間にあることが必要であり、望ましく
は、10～18重量%の間である。シリカ濃度が3重量
%以下であると、研磨速度が低く実用性がない。シリカ
濃度が25重量%以上になると、粗大な凝集粒子が生じ
易くスクラッチ等が発生し易い。研磨時の酸化珪素濃度
が高くなれば研磨加工速度自体は増大するが約15重量
%を超えるあたりでその値は飽和値に達してしまう。

【0012】本発明においては、単位長あたりの導電率
の数値 (micro-Siemens) を酸化珪素1重
量%当りに換算した数値で示し、その25℃における数
値は10mS/m/1%-SiO₂以上であることが必
要である。好ましくは15mS/m/1%-SiO₂以
上にするにより、研磨速度は一層上昇する。研磨用
組成物に導電性を付与する成分については特に限定を受
けるものではないが、アルカリ金属、コリン、テトラメ
チルアンモニウムまたはアンモニウムの塩のうち少なく
とも一つを添加剤として用いることができる。アルカリ
金属、コリン、テトラメチルアンモニウムまたはアンモ
ニウムの塩の形態としては、フッ化物、塩化物、臭化
物、硫酸塩、硝酸塩、炭酸塩、炭酸水素塩、炭素酸塩、
ヨウ素酸塩、過塩素酸塩、ホウ酸塩、リン酸塩等の無機
塩類、クエン酸塩、シュウ酸塩、酒石酸塩、等の有機酸
塩類があげられるが、このうち研磨性能の安定性といっ
た面から、特に硝酸塩とすることが好ましい。これらの
塩は複合して用いても良い。

【0013】本発明においては研磨用組成物のpHは8
～11の範囲にあることが肝要である。pHが8以下で
あると研磨速度は著しく低下し実用の範囲からは外れ
る。また、pHが11以上になると、コロイダルシリカ
が凝集をはじめて本発明の範囲から外れ、そのため研磨
用組成物の安定性が低下してこれも実用の範囲から外れ
る。そしてまた、このpHは摩擦、熱、外気との接触あ
るいは他の成分との混合等、考えられる外的条件の変化

* [0016]

10

研磨装置：(株)マルトー製、卓上小型研磨機ドクターラップ

定盤回轉數：82RPM

研磨布：SUBA800（ロデールニッタ社製）

研磨用組成物流量：20 ml / 分

加工荷重: 326 gf/cm^2

加工時間：30分

ワークピース：15mm角に裁断したもの3枚を同時研
磨

研磨速度は、研磨前後の重量差より求めた。研磨用組成物の pH は pH メーターを用い測定した。測定にあたっては、pH 6.86 と 9.18 の pH 標準溶液であらかじめ pH 電極の校正を行った後測定した。酸化珪素 1 重量%あたりの導電率は導電率計にて測定した値を酸化珪素濃度で除して用いた。更に研削面の評価は、AFM を用いて表面粗さ (Ra) を測定した。

【0017】实施例1~10、比较例1~5

表1、表2および表3に、実施例および比較例で使用した研磨用組成物の組成と物性、および前記方法に準拠して得られた研磨試験結果を併記する。

[0018]

【表1】

【0015】本発明の研磨用組成物を使用したタンタル酸リチウムまたはニオブ酸リチウムよりなる酸化物単結晶ウェーハの鏡面仕上げの研磨方法は、装置として例えば、スピードファム・アイベック（株）社製SH-24型片面機、DSM-12B型両面機などである。これら研磨装置で本発明の研磨用組成物を使いタンタル酸リチウム、ニオブ酸リチウムなどの酸化物単結晶ウェーハを研磨速度を一定の高いレベルに保った上で、優れた仕上げり面粗さを持った鏡面を得ることができる。

水準		実施例 1	実施例 2	実施例 3	比較例 1	比較例 2
酸化処理濃度 (%)		14.5	14.5	14.5	14.5	14.5
一次粒子径 A (nm)		85	85	40	85	40
二次粒子径 B (nm)		98	98	45	98	45
粒径比 (B/A)		1.15	1.15	1.13	1.15	1.13
添加剤**	RaCl	0.1		0.2		
	Na ₂ SO ₄		0.05			
物性	pH	10.1	10.1	9.8	10.4	9.9
	吸水率 *	21	20	33	9.2	8.8
溶解速度 (nm/分)		35	34	41	24	20
耐擦さ Ra (nm)		3.7		3.4	3.8	3.9

* $\text{Na}_2\text{S}/\text{D}-1\% \text{ SiO}_2$, ** $\text{MoI}/\text{K}-\text{SiO}_2$

【0019】表1は本発明の実施例である添加剤を加えた場合と、添加剤を加えない従来例による比較例の結果を示すものである。塩化ナトリウムあるいは芒硝等の塩類の添加物を加えることにより、導電率を実施例1〜3に示す如く $10\text{ mS}/\text{m} \cdot 1\% \text{ SiO}_2$ 以上の範囲に調整することができ、良好な研磨速度と面粗さが得られる。

る。これに対し、添加剤を加えない場合は導電率は比較例1、2に示すように10 mS/m-1% SiO₂未焼となつて、研磨速度は実施例の約半分の値を示し、好ましくない。

[0020]

【表2】

水準	実施例4	実施例5	比較例3	比較例4	比較例5
酸化珪素濃度 (%)	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5
一次粒子径 A (nm)	100	100	45	52	18
二次粒子径 B (nm)	120	120	95	75	20
粒径比 (B/A)	1.20	1.20	2.11	1.44	1.11
添加剤**	NaCl	0.05	0.1	0.2	0.2
物性	pH	10.1	10.1	10.1	10.1
	導電率 *	17	23	32	31
	研磨速度 (nm/分)	34	38	37	34
	面粗さ Ra (nm)		3.8	スクラッチ発生	スクラッチ発生

* mS/cm-1% SiO₂, ** Mol/kg-SiO₂

【0021】表2において比較例3及び4は粒径比B/Aを本発明範囲1.4より大きくしたものの例であり、比較例5は一次粒子径を本発明範囲である40nmに達しない小粒径のものをを用いた例である。表2の結果より明らかな如く、粒径比B/Aが1.4を超えた場合はス*

*クラッチの発生が見られて好ましくなく、また、一次粒子径が40nm以下であると研磨速度が本発明の実施例4、5の約半分になってしまい、好ましくない。

【0022】

【表3】

水準	実施例6	実施例7	実施例8	実施例9	実施例10
酸化珪素濃度 (%)	14.5	14.5	14.5	14.5	18.0
一次粒子径 A (nm)	100	100	100	88	40
二次粒子径 B (nm)	120	120	120	98	45
粒径比 (B/A)	1.20	1.20	1.20	1.15	1.11
添加剤**	NaNO ₃ THA ₃ CO ₃ Na ₂ CO ₃ KHCO ₃	0.05	0.1	0.2	0.1
物性	pH	10.1	10.1	10.1	10.3
	導電率 *	17	22	31	31
	研磨速度 (nm/分)	36	40	42	36
	面粗さ Ra (nm)		3.8	3.7	3.5

* mS/cm-1% SiO₂, ** Mol/kg-SiO₂
THA₃CO₃、炭酸テトラメチルアンモニウム

【0023】表3においては、添加剤を硝酸塩あるいは炭酸塩としたものの実施例を示す。いずれの例においても良好な研磨速度と面粗さを得ることができる。

【0024】

【発明の効果】以上の実施例および比較例の結果から示される通り、本発明になる研磨用組成物を用いれば、例えば硬質のタンタル酸リチウム、ニオブ酸リチウムなどの酸化物単結晶ウェーハの鏡面仕上げ研磨において、従来のものより倍以上の高い研磨速度が得られることは明*

※らぬであり、しかも表面粗さについては、高精度の鏡面仕上げの面を得ることが可能である。本発明になる研磨用組成物により、従来多大な時間と手間を要していた鏡面仕上げ研磨（ポリッシング）工程の時間短縮および効率の向上を図ることが可能となり、そのことが例えば移動体通信の重要部品である弾性表面波素子や電気光学素子の生産性向上とコスト引き下げに多大に寄与するものである。

フロントページの続き

(72)発明者 市川 真也
神奈川県横浜市早川2647 スピードファ
ム・アイベック株式会社内

(72)発明者 小島 孝仁
神奈川県横浜市早川2647 スピードファ
ム・アイベック株式会社内